

Fresh dislocations in GaN

Ichiro Yonenaga and Shun Itoh, IMR, Tohoku University

GaN and related nitride compounds are attracting tremendous interests as wide-bandgap semiconductors for applications in blue and ultraviolet LED and LDs. Fundamental knowledge on kinetics and properties of defects is crucial for addressing their stable and efficient functionalities. This weak beam TEM images shows fresh dislocations induced by plastic deformation for understanding the above purposes.



は じ め に

研究部共同利用委員会 委員長 米 永 一 郎

平成19年度の研究部共同研究報告をお届けいたします。国立大学の独立法人化により今までに経験のない組織・体制の改革が進められています。法人化後も、全国横断的に行われる共同利用研究の使命はますます重要になるものと思います。今後とも皆様のご支援をお願い致します。

平成19年度の研究部の共同研究では、国立大学法人67件（28大学）、公立大学6件（3大学）、私立大学8件（8大学）、国立共同利用機関1件、独立行政法人8件（4機関）、高等専門学校4件（4高専）、合計で94件が採択・実施されました。

本報告は平成19年度に行われたこれらの研究部共同研究報告書をまとめたもので、第1部に重点研究報告、第2部に一般研究報告、第3部に若手萌芽研究報告、第4部に研究発表リストを分野別に収録しています。

なお、ここに掲げました研究部共同研究とは別に量子エネルギー材料科学国際研究センター（58件）、金属ガラス総合研究センター（93件）および強磁場超伝導材料研究センター（80件）において共同研究が行われております。それぞれの報告書及びKINKEN Research Highlightsにも目を通して頂きますと本所における共同研究および共同利用の全体像が明らかになることと思います。

平成20年 6月